

Микросхема статического оперативного запоминающего устройства (СОЗУ) емкостью 16М (1М × 16 бит) К1645РУ6Н4

Основные характеристики микросхемы

- Информационная емкость 16М (1М × 16 бит);
- Напряжение питания от 3,0 до 3,6 В;
- Время выборки данных по адресу не более 10 нс;
- Динамический ток потребления не более 200 мА;
- Ток потребления в режиме хранения не более 30 мА;
- Рабочий диапазон температур от минус 60 °С до плюс 100 °С.

Тип корпуса:

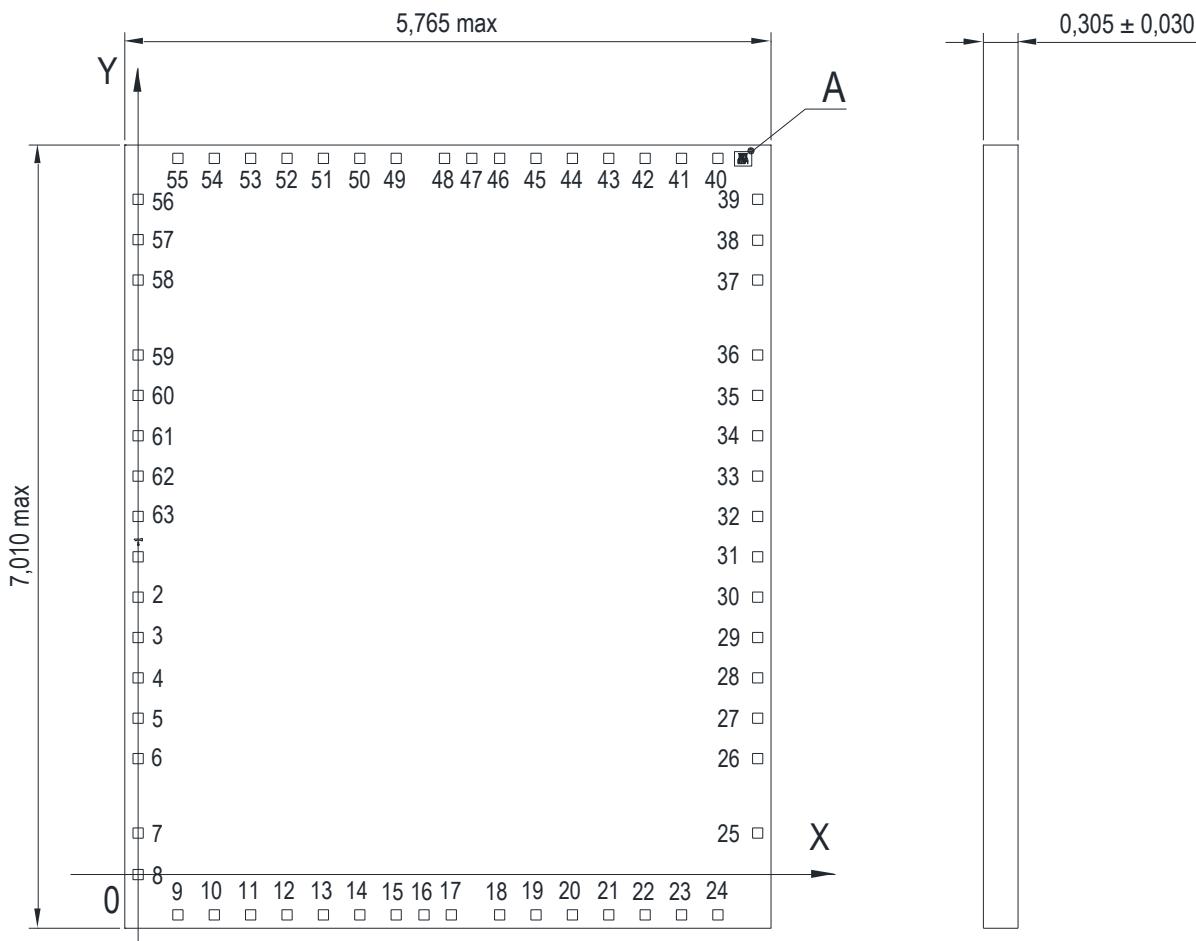
- бескорпусное исполнение.

Общее описание и область применения микросхемы

Микросхемы интегральные К1645РУ6Н4 (далее – микросхемы) – статические оперативные запоминающие устройства (СОЗУ) с произвольной выборкой информационной емкостью 16М и организацией 1М слов по 16 бит – предназначены для применения в блоках и устройствах памяти общих и специальных вычислительных систем с большими потоками обработки информации.

Описание функционирования микросхем приведено в ТСКЯ.431223.021СП.

Габаритный чертеж



- 1 Размеры контактных площадок (КП) кристалла ($90 \times 90^\circ$) мкм.
Материал КП – AlCu (0,5 % Cu).
Координаты КП – см. таблицу 1.
 - 2 Номера КП кристалла присвоены условно. КП номер 1 отмечена стрелкой (↓)
 - 3 А – маркировка IDMI0234 указана на каждом кристалле.

Рисунок 1 – Микросхема К1645РУ6Н4

Таблица 1 – Координаты КП

Номер КП	Обозначение КП	Координаты КП, мкм		Номер КП	Обозначение КП	Координаты КП, мкм	
		X	Y			X	Y
1	Ucc	0	2795,0	33	D5	5450,0	3505,0
2	D11	0	2440,0	34	Ucc	5450,0	3860,0
3	D10	0	2085,0	35	D6	5450,0	4215,0
4	GND	0	1730,0	36	D7	5450,0	4570,0
5	D9	0	1375,0	37	GND	5450,0	5230,0
6	D8	0	1020,0	38	nOE	5450,0	5580,0
7	Ucc	0	365,0	39	Ucc	5450,0	5940,0
8	GND	0	0	40	Ucc	5100,0	6300,0
9	Ucc	350,0	-355,0	41	A10	4780,0	6300,0
10	A9	670,0	-355,0	42	A11	4460,0	6300,0
11	A8	990,0	-355,0	43	A12	4140,0	6300,0
12	A7	1310,0	-355,0	44	A13	3820,0	6300,0
13	A6	1630,0	-355,0	45	A14	3500,0	6300,0
14	A5	1950,0	-355,0	46	nBLE	3180,0	6300,0
15	nWE	2270,0	-355,0	47	GND	2935,0	6300,0
16	GND	2515,0	-355,0	48	Ucc	2695,0	6300,0
17	Ucc	2755,0	-355,0	49	nBHE	2270,0	6300,0
18	nCE	3180,0	-355,0	50	A15	1950,0	6300,0
19	A4	3500,0	-355,0	51	A16	1630,0	6300,0
20	A3	3820,0	-355,0	52	A17	1310,0	6300,0
21	A2	4140,0	-355,0	53	A18	990,0	6300,0
22	A1	4460,0	-355,0	54	A19	670,0	6300,0
23	A0	4780,0	-355,0	55	GND	350,0	6300,0
24	GND	5100,0	-355,0	56	NC	0	5940,0
25	GND	5450,0	365,0	57	NC	0	5585,0
26	D0	5450,0	1020,0	58	Ucc	0	5230,0
27	D1	5450,0	1375,0	59	D15	0	4570,0
28	Ucc	5450,0	1730,0	60	D14	0	4215,0
29	D2	5450,0	2085,0	61	GND	0	3860,0
30	D3	5450,0	2440,0	62	D13	0	3505,0
31	GND	5450,0	2795,0	63	D12	0	3150,0
32	D4	5450,0	3150,0				

КП кристалла NC с номерами 56, 57 не разваривать.

Информация для заказа

Обозначение	Маркировка (на таре)	Тип корпуса	Температурный диапазон, °C
K1645РУ6Н4	K1645РУ6Н4	Бескорпусная	от – 60 до 100

Микросхемы поставляются в виде отдельных кристаллов, получаемых разделением пластины (поставляются в кейсах).

Лист регистрации изменений

№ п/п	Дата	Версия	Краткое содержание изменения	№№ изменяемых листов
1	08.11.2024	1.0.0	Введена впервые	